

附表：第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源

批次	溫室氣體排放源		條件說明	計算說明
	行業別	製程別		
第一批	發電業	汽力機組鍋爐發電程序	具備汽力機組鍋爐發電程序且採用化石燃料者。	一、溫室氣體排放源具有左列任一製程或設備者，應依規定以管制編號為單位，進行全廠(場)溫室氣體年排放量盤查及登錄。 二、溫室氣體排放源應依下列計算方式，判定全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量： 溫室氣體年排放量(公噸二氧化碳當量/年)＝當年原料、燃料使用量、產品產量或其他經中央主管機關認定之操作量
		複循環機組發電程序	具備複循環機組發電程序且採用化石燃料者。	
	鋼鐵業	一貫煉鋼鋼胚生產程序	包含煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等程序，且生產鋼胚者。	
		電弧爐碳鋼鋼胚生產程序	包含電弧爐煉鋼程序、精煉爐及連續鑄造程序，且生產碳鋼鋼胚者。	
		電弧爐不銹鋼鋼胚生產程序	包含電弧爐煉鋼程序、轉爐、真空精煉爐及連續鑄造程序，且生產不銹鋼鋼胚者。	
		H型鋼生產程序	包含加熱、軋製、噴砂及研磨程序，且生產H型鋼者。	
		不銹鋼熱軋鋼捲(板)生產程序	包含加熱及軋製程序，且生產不銹鋼熱軋鋼捲(板)者。	
	石油煉製業	石油煉製程序	以礦產原油或油頁岩等為原料，從事汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、石油醚、有機溶劑或其他石油品之提煉者。	
	水泥業	具備熟料生產程序	熟料生產程序包含生料研磨製程及熟料燒成製程。其中熟料係指含氧化鈣(CaO)、氧化矽(SiO ₂)、氧化鋁(Al ₂ O ₃)及氧化鐵(Fe ₂ O ₃)之原料，依適當比例並經研磨後投入於水泥窯爐中，燒至部分熔融所得以矽酸鈣為主要礦物成分之水硬性膠凝物質。	
	半導體業	積體電路晶圓製造程序	包含經由物理氣相沈積、化學氣相沈積、光阻、微影、蝕刻、擴散、離子植入、氧化與熱處理等製	

			程；僅從事晶圓封裝、磊晶、光罩製造、導線架製造、二極體製造及發光二極體製造等作業或製程中確實未使用含氟溫室氣體者，非屬本公告之適用對象。	(公噸、公秉或千立方公尺/年)×排放係數 (公噸/公噸、公秉/公噸或千立方公尺/公噸)×溫暖化潛勢 三、原(物)料、燃料使用量、產品產量或其他經中央主管機關認定之操作量，應依前一年度實際操作量計算之。但公告後始設立之排放源，其操作量以最大設計值為準。
	薄膜電晶體液晶顯示器業	具備薄膜電晶體元件陣列基板或彩色濾光片生產程序	薄膜電晶體液晶顯示器之製程中，包含擴散、薄膜、黃光顯影、蝕刻或彩色濾光片等程序；製程中確實使用含氟溫室氣體，亦屬本公告之適用對象。	
	各行業	其他設備	全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放產生溫室氣體年排放量達二·五萬公噸二氧化碳當量。	